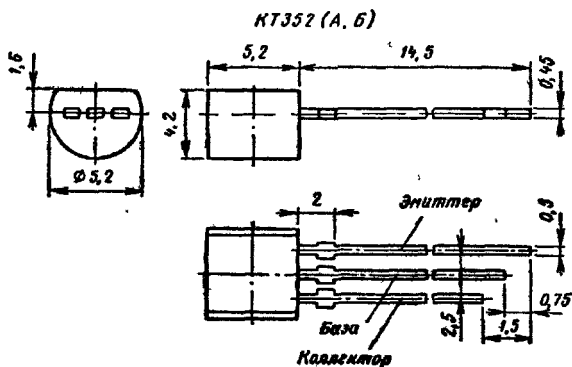


## КТ352А, КТ352Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветами: КТ352А — зеленой и розовой, КТ352Б — зеленой и желтой. Масса транзистора не более 0,3 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кв} = 1$  В,  $I_B = 200$  мА:

$T = +25$  °С:

КТ352А . . . . . 25...65\*...12

КТ352Б . . . . . 70...115\*...3

$T = -40$  °С, не менее . . . . . 0,3 значен

$T = +25$  °С . . . . . От 0,9 до

$T = +85$  °С . . . . . ний при  $T$

$T = +25$  °С . . . . .

Граничная частота коэффициента передачи тока при

$U_{кв} = 5$  В,  $I_B = 10$  мА, не менее . . . . . 200 МГц

типичное значение . . . . . 450\* МГц

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_K =$

$= 200$  мА,  $I_B = 20$  мА для КТ352А,  $I_B = 3$  мА для КТ352Б,

не более . . . . . 0,6 В

типичное значение . . . . . 0,37\* В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_K = 200$  мА,

$I_B = 20$  мА, для КТ352А,  $I_B = 3$  мА для КТ352Б, не более

типичное значение . . . . . 1,1 В

Обратный ток коллектора при  $U_{кв} = 10$  В, не более:

$T = +25$  °С . . . . . 1 мкА

$T = +85$  °С . . . . . 10 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{вв} = 4$  В, не более . . . . . 10 мкА

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кв} = 5$  В, не более

типичное значение . . . . . 15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{вв} = 1$  В, не более

типичное значение . . . . . 9,5\* пФ

типичное значение . . . . . 30 пФ

типичное значение . . . . . 20\* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база	20 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{св} \leq 10$ кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	5 В
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :	
$T \leq +30$ °С	300 мВт
$T = +85$ °С	162,5 мВт
Типовое сопротивление переход — среда	0,4 °С/мВт
Температура рп перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-40 +85 °С

<sup>1</sup> В диапазоне температур +30 +85 °С допустимое значение рассеиваемой мощности принимается линейно

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5..2 мм

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса — 1 мм при температуре не выше +250 °С и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С